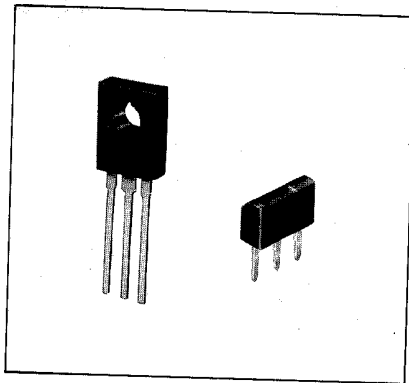


2SB786 2SB1076M

2SB786 2SB1076M

トランジスタ

2SBタイプ



●外形寸法図

2SB786

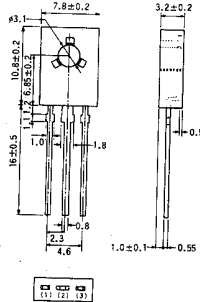


図1 JEDEC: TO-126M

2SB1076M

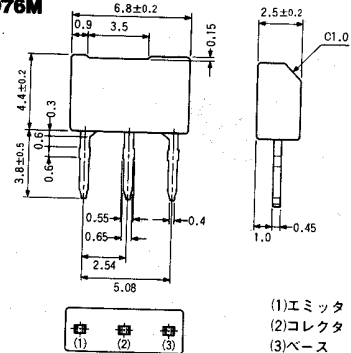


図2 ATR

(単位: mm)

(1)エミッタ
(2)コレクタ
(3)ベース

2A 5Wタイプ 2SB786, 1Wタイプ 2SB1076Mのダーリントトランジスタです。

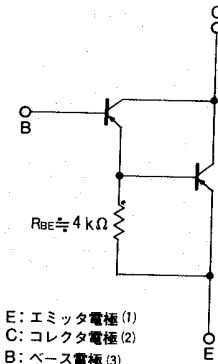
▶特長

- ・ダーリントン接続で高 h_{FE} である。
- ・BE間に約 $4k\Omega$ の抵抗を内蔵——
リーク電流の過度依存性も通常トランジスタと変わらない。
- ・裏面もモールドで覆われており、絶縁が不要です(2SB786)。

用途

種ソレノイドドライブ
子ガバナー制御

内部等価回路



E: エミッタ電極 (1)
C: コレクタ電極 (2)
B: ベース電極 (3)

図3

●絶対最大定格 ($T_a=25^\circ C$)

項目	記号	最大定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	-40	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CER}	-40	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-2	A
コレクタ損失	2SB786	5	W
	2SB1076M	1	
接合部温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55~150	$^\circ C$

●電気的特性 ($T_a=25^\circ C$)

項目	記号	Min.	Typ.	Max.	単位	条件
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV_{CER}	-40	—	—	V	$I_C/I_E=-1mA, R_{BE}=10k\Omega$
コレクタ・ベース降伏電圧	BV_{CB0}	-40	—	—	V	$I_C=-50\mu A$
エミッタ・ベース降伏電圧	BV_{EB0}	-5	—	—	V	$I_E=-50\mu A$
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	—	—	-1	μA	$V_{CB}=-24V$
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	—	—	-1	μA	$V_{EB}=-4V$
エミッタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	-0.80	-1.5	V	$I_C/I_E=-0.6A/-1.2mA$
直流電流増幅率	h_{FE}	1000	—	—	—	$V_{CE}/I_C=-3V/-0.5A$
利得帯域幅積(トランジション周波数)	f_t	—	150	—	MHz	$V_{CE}=-6V, I_E=0.1A$
出力容量	C_{ob}	—	11	—	pF	$V_{CB}=-10V, I_E=0, f=1MHz$